

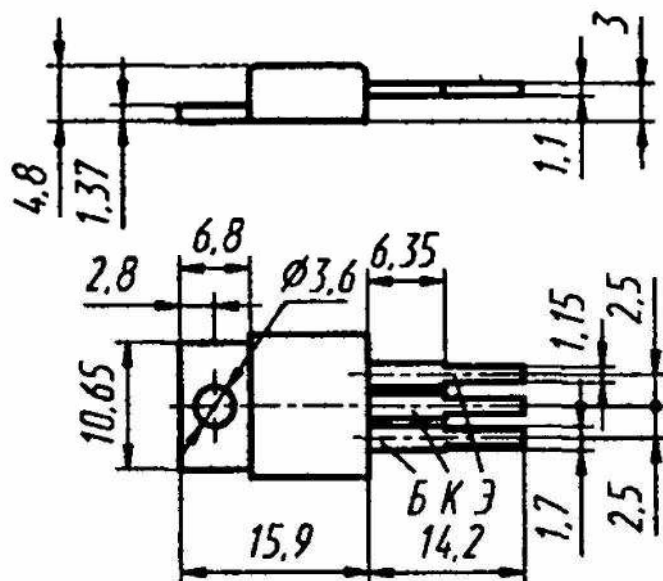
КТ850А, КТ850Б

Транзисторы кремниевые мезапланарные структуры *n-p-n* усилительные. Предназначены для применения в усилителях мощности, переключающих устройствах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 2,5 г.

Изготовитель — акционерное общество «Кремний», г. Брянск.

КТ850(А,Б)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кз} = 10$ В, $I_k = 0,5$ А:

КТ850А	40...200
КТ850Б, не менее	20

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кз} = 10$ В, $I_k = 0,1$ А, не менее

20 МГц

Граничное напряжение при $I_k = 30$ мА, не менее:

КТ850А	200 В
КТ850Б	250 В

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при $I_k = 0,5$ А, $I_b = 0,1$ А, не более

1 В

Напряжение насыщения база—эмиттер при $I_k = 0,5$ А, $I_b = 0,1$ А, не более

1,6 В

Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = U_{КБ, \text{МАКС}}$

не более:

КТ850А	0,1 мА
КТ850Б	0,5 мА

Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 5 \text{ В}$,

не более:

КТ850А	0,1 мА
КТ850Б	0,5 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база:

КТ850А	250 В
КТ850Б	300 В

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер
при $R_{БЭ} = 1 \text{ кОм}$, $dU/dt = 250 \text{ В/мкс}$:

КТ850А	200 В
КТ850Б	250 В

Постоянное напряжение база—эмиттер..... 5 В

Постоянный ток коллектора 2 А

Импульсный ток коллектора при $t_{и} = 2 \text{ мс}$,

$Q = 2$ 3 А

Постоянный ток базы 0,5 А

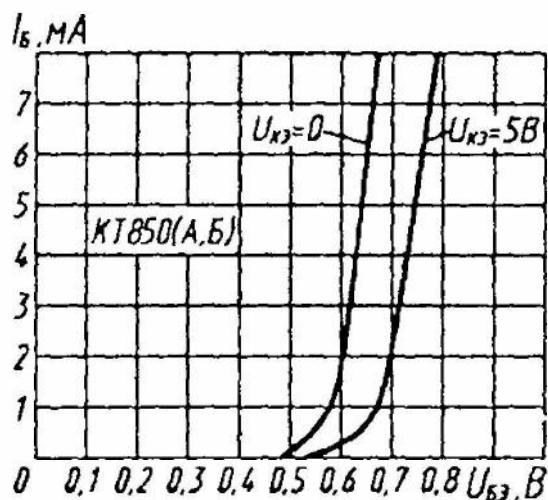
Постоянная рассеиваемая мощность коллек-
тора при $T_{к} = -60...+25 \text{ }^{\circ}\text{С}$ 25 Вт

Температура p - n перехода $+150 \text{ }^{\circ}\text{С}$

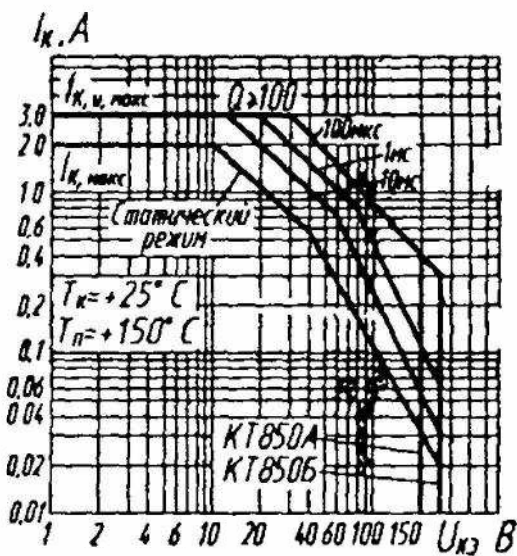
Температура окружающей среды $-60...T_{к} =$
 $= +100 \text{ }^{\circ}\text{С}$

Допускается одноразовый изгиб выводов не ближе 2,5 мм от корпуса транзистора под углом 90° радиусом закругления не менее 0,8 мм.

Пайка выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора при температуре $+260 \text{ }^{\circ}\text{С}$ в течение не более 3 с
Запрещается припайка основания транзистора к теплоотводу

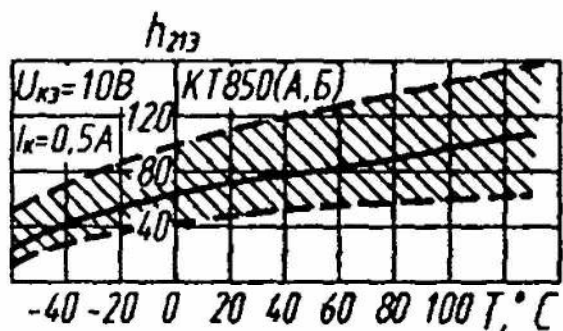
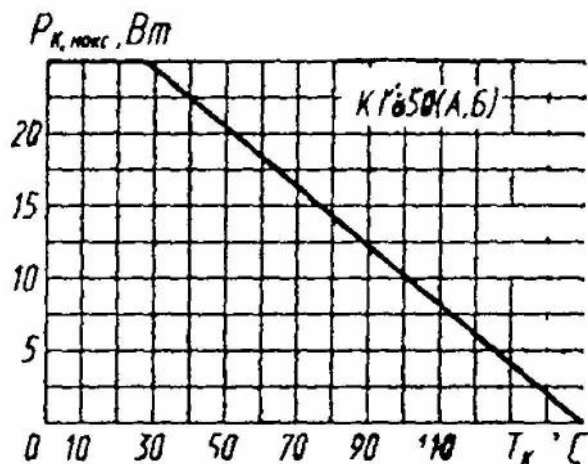


Входные характеристики

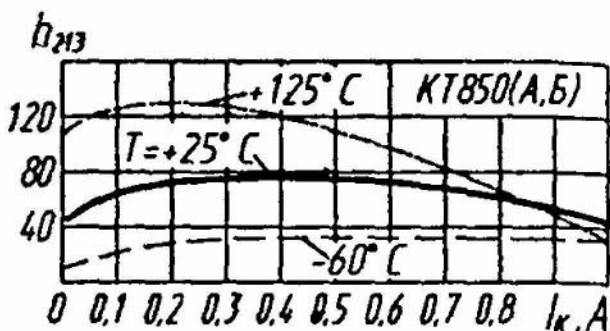


Области максимальных режимов

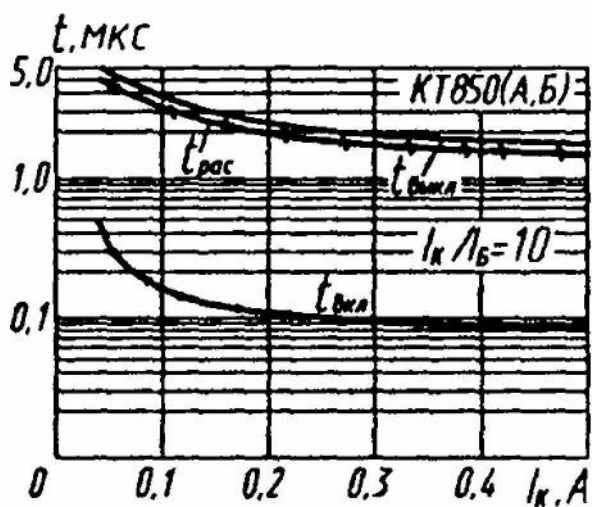
Зависимость максимально допустимой постоянной рассеиваемой мощности коллектора от температуры корпуса



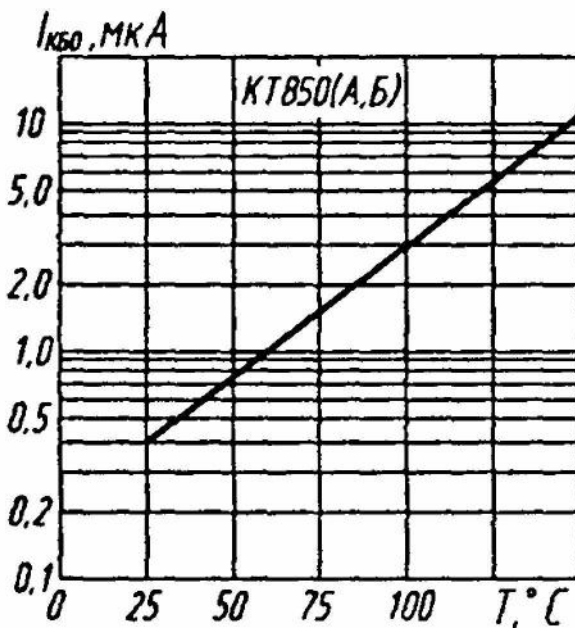
Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от температуры



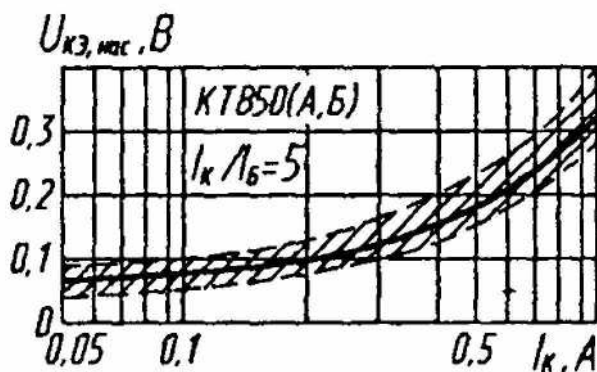
Зависимости статического коэффициента передачи тока от тока коллектора



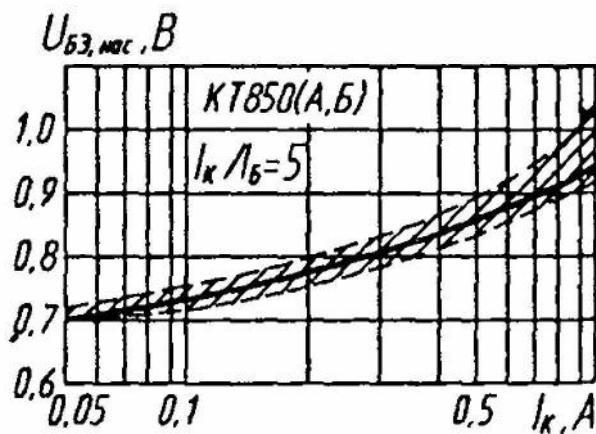
Зависимости времени включения, выключения и рассасывания от тока коллектора



Зависимость обратного тока коллектора от температуры



Зона возможных положений зависимости напряжения насыщения коллектор—эмиттер от тока коллектора



Зона возможных положений зависимости напряжения насыщения база—эмиттер от тока коллектора